

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 28 年 3 月 10 日 (2016.3.10)

【公表番号】特表 2015-508233 (P2015-508233A)  
 【公表日】平成 27 年 3 月 16 日 (2015.3.16)  
 【年通号数】公開・登録公報 2015-017  
 【出願番号】特願 2014-556595 (P2014-556595)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

H 0 4 N 5/374 (2011.01)

【F I】

H 0 1 L 27/14 F

H 0 1 L 27/14 A

H 0 4 N 5/335 7 4 0

【手続補正書】  
 【提出日】平成 28 年 1 月 22 日 (2016.1.22)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

裏面照射型センサを作製する方法であって、

表面、裏面、および前記表面と前記裏面との間の厚さを有する薄膜半導体薄片を提供するステップを備え、前記半導体薄片は第 1 の導電性を有しており、前記方法はさらに、前記薄片の前記表面において前記半導体薄片内にドーブ領域を形成するステップを備え、前記ドーブ領域は第 2 の導電性を有しており、前記方法はさらに、前記半導体薄片の前記裏面に仮キャリアを接触させるステップと、前記半導体薄片の表側に前記ドーブ領域への電氣的接続部を形成するステップと、前記裏面から前記仮キャリアを取り除くステップと、前記半導体薄片から裏面照射型センサを作製するステップとを備え、前記半導体薄片の厚さは、前記裏面照射型センサの作製中に実質的に変化しないままである、方法。

【請求項 2】

裏面照射型センサを作製する方法であって、

第 1 の面および第 1 の導電性を有する半導体ドナー体を提供するステップと、前記第 1 の面において前記半導体ドナー体内にドーブ領域を形成するステップとを備え、前記ドーブ領域は第 2 の導電性を有しており、前記方法はさらに、劈開面を規定するように前記半導体ドナー体の第 1 の面にイオンを注入するステップと、前記劈開面において前記半導体ドナー体から半導体薄片を劈開するステップとを備え、前記劈開面は前記半導体薄片の裏面を形成し、前記半導体ドナー体の第 1 の面は前記半導体薄片の表面であり、前記表面は前記ドーブ領域を含んでおり、前記方法はさらに、前記半導体薄片の裏面に仮キャリアを接触させるステップと、前記半導体薄片の表側上に前記ドーブ領域への電氣的接続部を形成するステップと、前記裏面から前記仮キャリアを取り除くステップと、前記半導体薄片から裏面照射型センサを作製するステップとを備え、前記半導体薄片の前記表側と前記裏面との間の厚さは、前記裏面照射型センサの作製中に実質的に変化しない

いままである、方法。

【手続補正２】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図４

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 4】

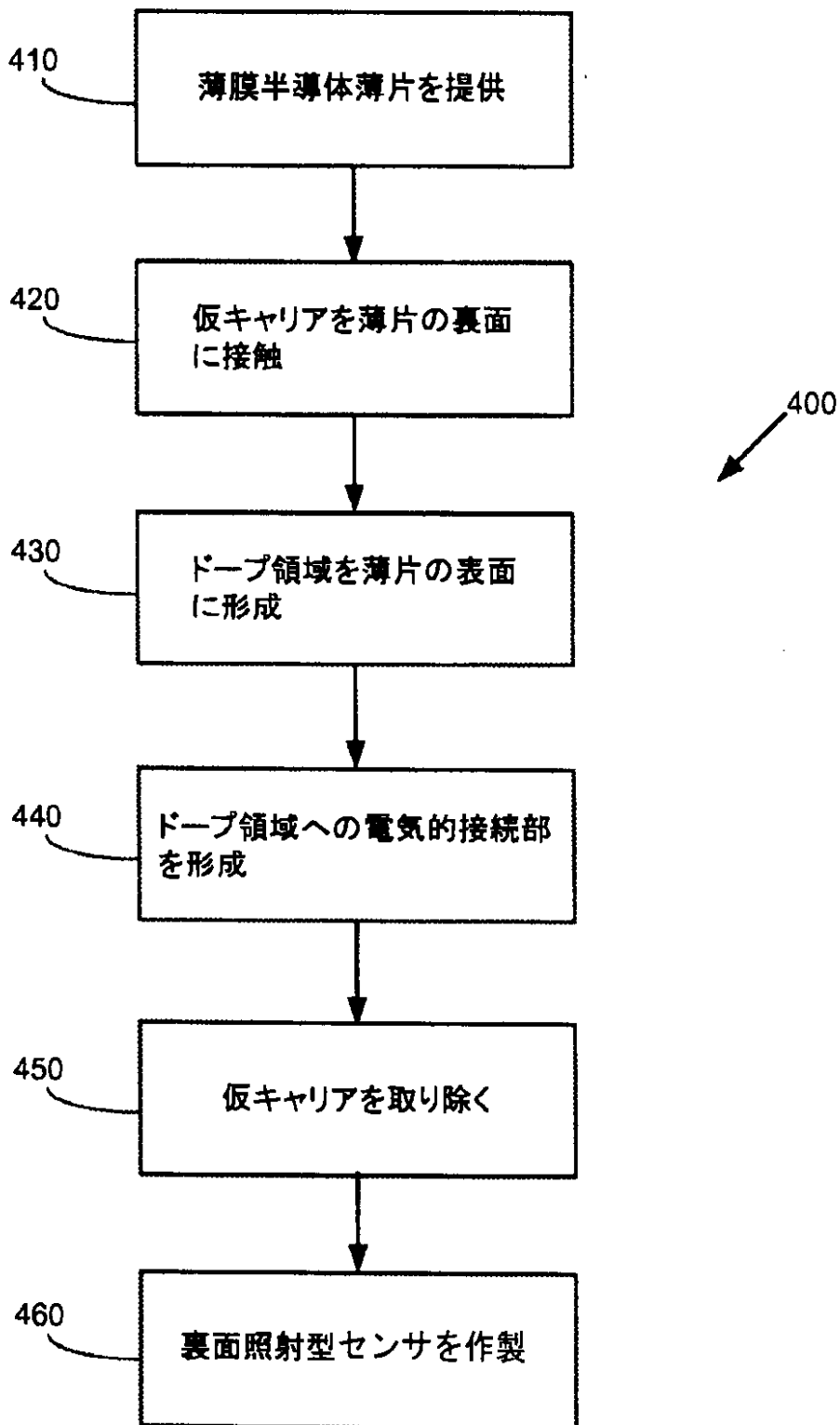


FIG. 4

【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図6】

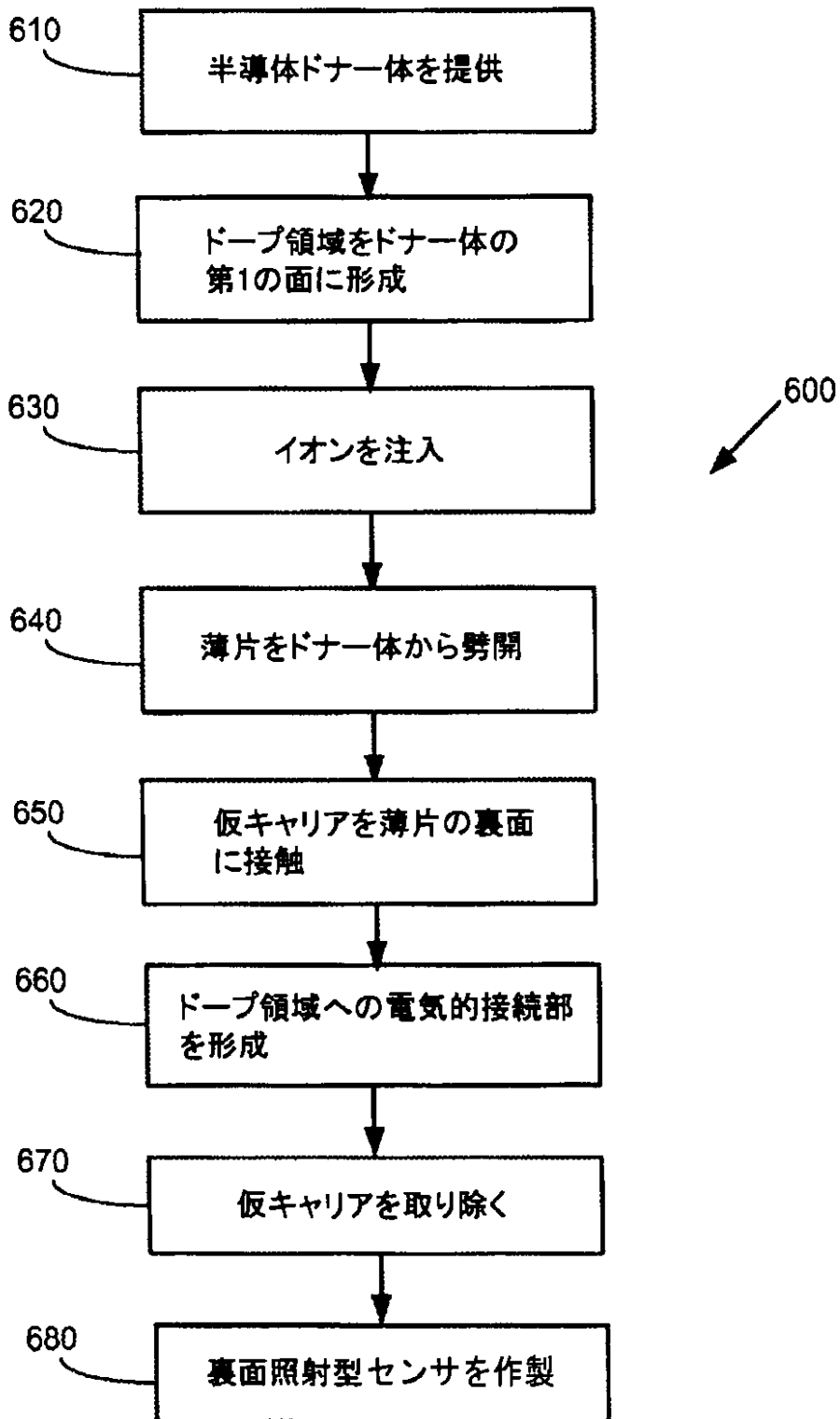


FIG. 6